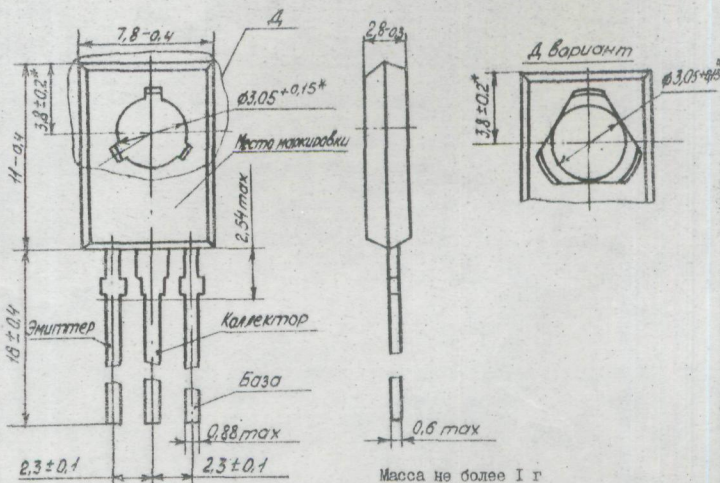




ТРАНЗИСТОРЫ КТ815А, КТ815Б,
КТ815В, КТ815Г

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные p-p-n транзисторы типов КТ815А, КТ815Б, КТ815В, КТ815Г в пластмассовом корпусе, предназначенные для применения в вклечных и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{ср} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	Н о р м а							
		КТ815А		КТ815Б		КТ815В		КТ815Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($U_{кБ} = 2 \text{ В}$, $I_B = 0,15 \text{ А}$)	h_{21}	40	275	40	275	40	275	30	275
Обратный ток коллектора ($U_{кБ} = 50 \text{ В}$), мкА	$I_{КБ0}$		50		50		50		50
($U_{кБ} = 65 \text{ В}$), мкА							50		50
Граничное напряжение ($I_B = 0,05 \text{ А}$, $t_U = 0,3-1 \text{ мс}$), В	$U_{кЭ0P}$	30		45		65		85	

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а								
		КТ815А		КТ815Б		КТ815В		КТ815Г		
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	
Обратный ток коллектор-эмиттер ($R_{БЭ} \leq 100 \text{ Ом}$), мкА ($U_{КЭ} = 50 \text{ В}$) ($U_{КЭ} = 65 \text{ В}$)	$I_{КЭР}$		100		100			100		100
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_{К} = 500 \text{ мА}$, $I_{Э} = 50 \text{ мА}$), В	$U_{КЭнас}$		0,6		0,6			0,6		0,6

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ:

Золото - г

ДРАГОМЕТАЛЛЫ НА ВЫВОДАХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ815А, КТ815Б, КТ815В, КТ815Г соответствуют техническим условиям
 А0.336.185 ТУ/02.

Место для
 штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена"

Место для
 штампа ОТК